

03407256 \*\*Image available\*\*  
MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICE

PUB. NO.: 03-070156 [ J P 3070156 A]  
PUBLISHED: March 26, 1991 (19910326)  
INVENTOR(s): OTOI FUMIO  
APPLICANT(s): OKI ELECTRIC IND CO LTD [000029] (A Japanese Company or  
Corporation), JP (Japan)  
APPL. NO.: 01-205601 [JP 89205601]  
FILED: August 10, 1989 (19890810)  
INTL CLASS: [5] H01L-021/76  
JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS -- Solid State Components)  
JOURNAL: Section: E, Section No. 1077, Vol. 15, No. 233, Pg. 99, June  
14, 1991 (19910614)

ABSTRACT

PURPOSE: To manufacture an element excellent in insulating properties of silicon island region and pattern accuracy by performing anode formation within high concentration of hydrofluoric acid solution as the first step, and performing anode formation within low concentration of hydrofluoric acid solution as the second step.

CONSTITUTION: As the first step, anode formation is done in, for example, 40% hydrofluoric acid solution so as to form a high density of porous silicon layer 15 at the surface of a substrate 11. Successively, as the second step, anode formation is done in 20% hydrofluoric acid solution so as to form a low density of porous silicon layer 16 for the porous silicon layer 15, in the deeper region of the substrate 11. Next, these porous silicon layers 15 and 16 are thermally oxidized. A high density of porous silicon oxide 15' made by oxidation of the porous silicon layer 15 is formed at the surface on its vicinity of the substrate 11, and in the deeper region, a low density of porous silicon oxide 16' made by oxidation of the porous silicon layer 16 is formed. And a plurality of silicon island regions 14 are separated electrically from each other. A transistor is formed to the silicon island region 14.

## ⑧公開特許公報(A) 平3-70156

⑨Int.Cl.<sup>3</sup>  
H 01 L 21/76識別記号  
M序内整理番号  
7638-5F

⑩公開 平成3年(1991)3月26日

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

## ⑪発明の名称 半導体装置の製造方法

⑫特 願 平1-205601

⑬出 願 平1(1989)8月10日

⑭発明者 音居文雄 東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 沖電気工業株式会社内

⑮出願人 沖電気工業株式会社 東京都港区虎ノ門1丁目7番12号

⑯代理人 弁理士 葉池 弘

## 明 碑 書

## 1. 発明の名称

半導体装置の製造方法

## 2. 特許請求の範囲

フッ化水素酸浴液中で陽極化成して、シリコン基板を裏面側から所定の深さまで多孔質シリコン層とし、その後、該多孔質シリコン層の酸化工程を有する半導体装置の製造方法において、

多孔質シリコン層形成工程は、まず第1段階として濃度の高いフッ化水素酸浴液中で陽極化成して、基板の裏面側を高密度の多孔質シリコン層とし、次に第2段階として濃度の低いフッ化水素酸浴液中で陽極化成して、基板の深い領域を低密度の多孔質シリコン層とすることを特徴とする半導体装置の製造方法。

## 3. 発明の詳細な説明

## (産業上の利用分野)

この発明は、多孔質シリコンの生成およびその酸化工程を有する半導体装置の製造方法に関するものである。

## (従来の技術)

多孔質シリコン酸化物によって完全地盤物分離されたシリコン島構造を有する半導体装置の従来の製造方法を第3図に示す。この方法は、文献「沖電気研究開発部(1) P63~68」に開示される。

まず第3回において、1はP型シリコン基板であり、この基板1上に絶縁膜化膜2を被覆する。

次に、周知のホトリソエッティング技術にて分離開孔3を絶縁膜化膜2に形成する。しかし後、その分離開孔3を追ってP型不純物のイオン注入を行うことにより、その分離開孔3に対応する部分の基板1表面に高濃度のP型層4を形成する。(第3回図)

その後、イオン注入を行うことにより、絶縁膜化膜2下の基板1表面にN型層のシリコン島構造5を形成する。このシリコン島構造5の厚さはイオン注入加速度電圧によって制御される。この時、前記高濃度P型層4が形成されていた領域は、該高濃度P型層4によってN型層が形成されることが防止され、かつ基板1の他の領域と同様に低濃

底 P 型構造に戻る。(第3回(d))

次に、フッ化水素酸などの強酸性溶液中で P 型シリコン基板 1 を所定の深さまで陽極化成することにより、シリコン基板 1 の裏面側を、N 型のシリコン基板 5 を残して多孔質シリコン層 6 とする(第3回(d))。

かかる後、この多孔質シリコン層 6 に酸化処理を施すことにより、多孔質シリコン層 6 を多孔質シリコン酸化物 6' とする。これにより、複数のシリコン基板 5 は互いに多孔質シリコン酸化物(分離構造) 6' により電気的に分離される。(第3回(e))

その後、シリコン基板 5 上の地錆変化層 2 を除去する(第3回(f))。

その後、シリコン基板 5 に対してトランジスタを形成する。

(発明が解決しようとする課題)

しかるに、上記のような従来の製造方法では、多孔質シリコン層 6 の酸化工程により、①シリコン基板 5 に欠陥が発生しトランジスタ特性を劣化させる。

この酸化工程を有する半導体装置の製造方法において、多孔質シリコン層形成工程を次の通りとする。まず、第1段階として濃度の高いフッ化水素酸溶液中で陽極化成を行い、次に第2段階として濃度の低いフッ化水素酸溶液中で陽極化成する。

(作用)

フッ化水素酸溶液中での陽極化成によりシリコン基板に多孔質シリコン層を形成するわけであるが、この時、多孔質シリコン層の密度はフッ化水素酸溶液の濃度(フッ化水素酸の濃度)に左右される。第2回に示すように、フッ化水素酸の濃度が高ければ、多孔質シリコン層の密度は高くなり、フッ化水素酸の濃度が低ければ、多孔質シリコン層の密度も低くなる。したがって、上記この発明のように、まず第1段階として濃度の高いフッ化水素酸溶液中で陽極化成を行い、次に第2段階として濃度の低いフッ化水素酸溶液中で陽極化成を行えば、基板の裏面側には高密度(従来と同じ密度)の多孔質シリコン層が形成され、基板の深い階層には低密度の多孔質シリコン層が形成される。

化させる、②シリコン基板 1 に反りが発生し、後の製造工程上、バターン精度が悪くなるという問題点があった。

これらの問題点は多孔質シリコン層 6 の密度に依存し、密度を小さくすれば上記問題点は軽減される。しかし、多孔質シリコン層 6 の密度を小さくすれば、多孔質シリコン酸化物 6' の密度も小さくなり、地錆変化、また後に続くエッチング工程においてエッチング速度が早いためにバターン異常という問題も発生するので、多孔質シリコン層密度を小さくすることはできなかった。

この発明は、以上述べた多孔質シリコン層の酸化工程により発生するシリコン基板の欠陥および基板の反りを軽減し、かつ地錆特性に優れ、エッチングによるバターン異常などの発生もない半導体装置の製造方法を提供することを目的とする。(課題を解決するための手段)

この発明は、フッ化水素酸溶液中で陽極化成して、シリコン基板を裏面側から所定の深さまで多孔質シリコン層とし、その後、該多孔質シリコン

層の酸化工程を有する半導体装置の製造方法において、多孔質シリコン層が形成されることになる。そして、このような多孔質シリコン層を酸化して多孔質シリコン酸化物を形成すれば、多孔質シリコン層の密度に応じて、裏面付近は密度の高い(従来と同じ密度の)多孔質シリコン酸化物となり、深い階層は密度の低い多孔質シリコン酸化物となる。そして、裏面付近に従来と同じ高密度の多孔質シリコン酸化物が形成されれば、シリコン基板の地錆特性に優れ、かつエッチングによるバターン異常も発生しない。一方、深い階層は前述のように多孔質シリコン層密度が低く、これを酸化して多孔質シリコン酸化物とするため必要する時間が長いので、シリコン基板での欠陥および基板の反りが軽減される。

(実施例)

以下この発明の一実施例を第1回を参照して説明する。

この発明の一実施例では、第1回に示すように、P 型シリコン基板 1 に地錆変化層 2 を

接着し、この変化部1-2にホトリソエッティング技術にて分離開孔部1-3を形成し、その分離開孔部1-3を通して基板1-1にP型不純物のイオン注入を行ひ、さらに全面にN型不純物のイオン注入を行うことにより、変化部1-2下のみにN型層のシリコン島構造1-4を形成するまでは第3回の従来技術と同様である。

次に、従来技術では、フッ化水素酸溶液中で基板1-1の裏面から所定の深さまで一度に陽極化成を行ひ、多孔質シリコン層を形成するが、この発明の一実施例では、陽極化成(多孔質シリコン層の形成工程)を2段階に分けて行う。

まず、第1段階として、4.0%のフッ化水素酸溶液中で陽極化成を行ひ、第1回目に示すように基板1-1の裏面側に、従来と同程度の高密度の多孔質シリコン層1-5を形成する。続いて第2段階として、2.0%のフッ化水素酸溶液中で陽極化成を行ひ、前記多孔質シリコン層1-5に連続して第1回目に示すように低密度の多孔質シリコン層1-6を基板1-1の深い領域に形成する。

シリコン層1-6は、高密度多孔質シリコン層1-5の下5μm程度の深さまで形成するようとする。なお、第1回目に示すように、矢印は成膜電流の流れを示す。

上述のようにして基板1-1の深さ方向に密度の異なる多孔質シリコン層1-5、1-6を形成したならば、次にこの多孔質シリコン層1-5、1-6を例えば1000~1100°CウェットO<sub>2</sub>中で熱酸化する。これにより、第1回目に示すように、基板1-1の裏面付近には、多孔質シリコン層1-5を酸化してなる密度の高い多孔質シリコン酸化物1-5'が形成され、深い領域には、多孔質シリコン層1-6を酸化してなる密度の低い多孔質シリコン酸化物1-6'が形成される。そして、この多孔質シリコン酸化物1-5'、1-6'により複数のシリコン島構造1-4が互いに電気的に分離される。

その後はシリコン島構造1-4上の絶縁変化部1-2を除去し、シリコン島構造1-4に対してトランジスタを形成する。

(発明の効果)

ここで、第2回にフッ化水素酸溶液の濃度(フッ化水素酸の濃度)と得られる多孔質シリコン層の密度との関係を示す。この図より明らかなように、フッ化水素酸濃度を4.0%とすれば、1.0(g/cm<sup>3</sup>)程度の高密度の多孔質シリコン層1-5が得られる。一方、フッ化水素酸濃度を2.0%とすれば0.6(g/cm<sup>3</sup>)程度の低密度の多孔質シリコン層1-6が得られることになる。なお、この第2回の密度から、高密度の多孔質シリコン層1-5を得る第1回目においては、フッ化水素酸濃度は4.0±5%が適当である。フッ化水素酸濃度を5.0%以上とすれば密度はより高くなるが、多孔質シリコン層の裏面が割るため好ましくない。また、低密度の多孔質シリコン層1-6を得る第2回目においては、フッ化水素酸濃度は2.0~3.0%が適当である。また、例えばシリコン島構造1-4の試験深さを0.5μmとした場合は、高密度の多孔質シリコン層1-5はシリコン島構造1-4と同一の深さ、あるいはそれより深い1~2μmの深さまで形成するようとする。また、低密度の多孔質シリ

以上詳圖に説明したように、この発明の製造方法によれば、フッ化水素酸溶液の濃度を変えて陽極化成を2段階に分けて行って、基板の裏面側には高密度の多孔質シリコン層、基板の深い領域には低密度の多孔質シリコン層を形成するようにならうので、次のような効果が期待できる。

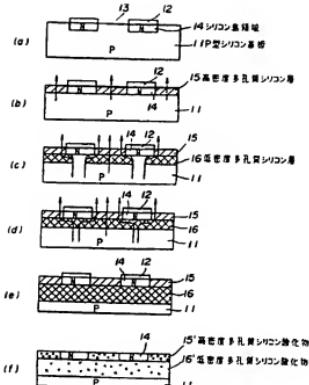
(1) 多孔質シリコン層を酸化して多孔質シリコン酸化物とした時、裏面付近は従来と同じ高密度の多孔質シリコン酸化物が形成されるので、シリコン島構造の絶縁特性に優れ、かつエッティングによるバーチャル接続も発生しない。即ち深い領域には多孔質シリコン酸化物1-5'が形成され、裏面付近には多孔質シリコン酸化物1-6'が形成される。そして、この多孔質シリコン酸化物1-5'、1-6'により複数のシリコン島構造1-4が互いに電気的に分離される。

(2) 図面の簡単な説明  
第1回はこの発明の半導体装置の製造方法の一

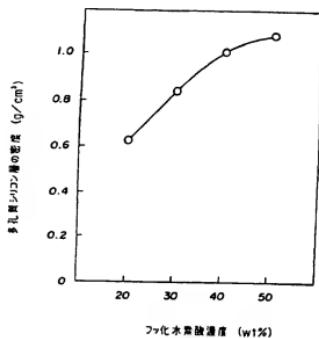
実験例を示す工程断面図、第2図はフッ化水素酸濃度と多孔質シリコン層密度の関係を示す特性図、第3図は従来の製造方法を示す工程断面図である。

1-1 … P型シリコン基板、1-5 … 高密度多孔質シリコン層、  
 1-5' … 低密度多孔質シリコン層、  
 1-6 … 高密度多孔質シリコン酸化物、1-6' … 低密度多孔質シリコン酸化物。

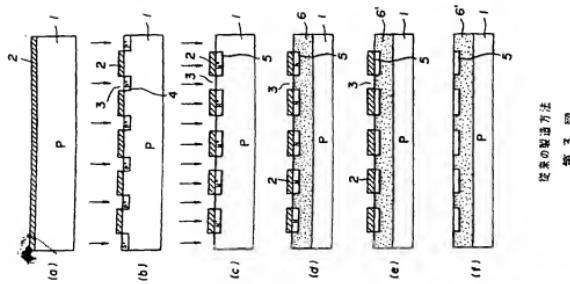
特許出願人 沖電気工業株式会社  
 代理人 弁理士 堀 池 弘



本発明の一実施例  
 第1図



HF濃度と多孔質シリコン層密度の関係  
 第2図



説明の図  
第3 図